

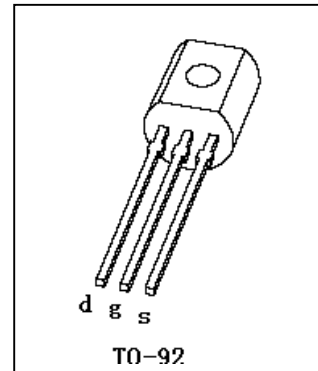
N 沟纵向 MOSFET

描述:

N 沟增强型 VDMOS, 高速开关, 无二次击穿

产品应用:

- 电话机电路
- 继电器电路
- 驱动电路等



工作条件 (T=25℃)

符号	参数	极限值	单位
V_{DS}	漏源电压	200	V
V_{GS}	栅源电压	± 20	V
I_D	漏电流	300	mA
P_D	Power Dissipation for Dual Operation	1	W
T_j, T_{SDG}	结温度和存储温度	-55 to +150	℃

热特性

$R_{th\ j-a}$	Thermal Resistance, Junction to Ambient	125	K/W
---------------	---	-----	-----

电学特性 $T_A=25^\circ\text{C}$

符号	参数	测试条件	最小	典型	最大	单位
BV_{DSS}	源漏击穿电压	$V_{GS} = 0V, I_D = 10\mu A$	200			V
I_{DSS}	零栅压时的漏极电流	$V_{DS} = 160V, V_{GS} = 0V$			1	μA
I_{GSS}	栅和衬底之间的漏电流	$V_{GS} = \pm 20V, V_{DS} = 0V$			± 100	nA
$V_{GS(th)}$	阈值电压	$V_{DS} = V_{GS}, I_D = 1mA$	0.4		1.8	V
$R_{DS(on)}$	导通电阻	$V_{GS} = 2.8V, I_D = 100mA$			5	Ω

交流特性

Ciss	输入电容	$V_{DS}=25V, V_{GS}=0V$ $f = 1MHz$		120		pF
Coss	输出电容			30		pF
Crss	反馈电容			15		pF

开关特性

t_{on}	Turn-On 时间	$V_{DD}=50V, I_D=250mA$ $V_{GS}=0 \text{ to } 10V$		6	10	ns
t_{off}	Turn-Off 时间			49	60	ns